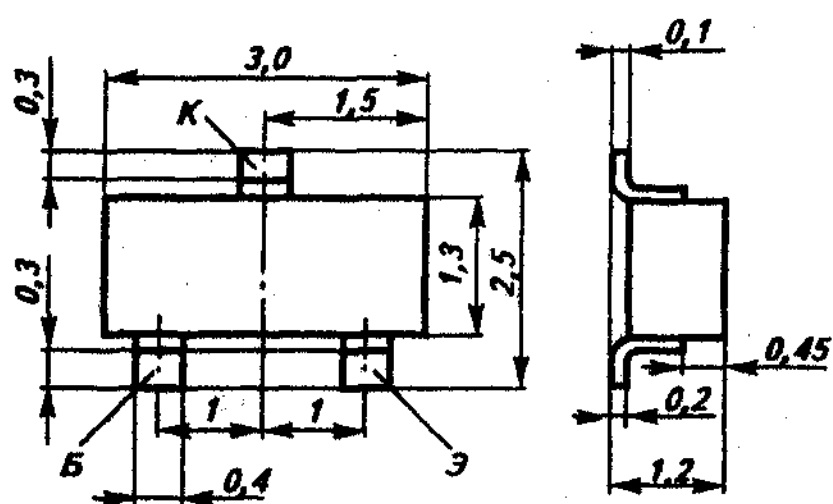
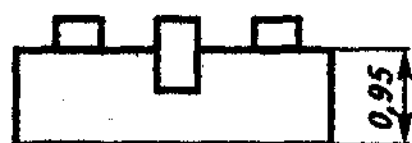


□ KT218A9, KT218B9, KT218B9, KT218Г9, KT218Д9, KT218E9



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры $p-n-p$ универсальные. Предназначены для применения в усилителях, генераторах и импульсных устройствах в составе гибридных интегральных микросхем с общей герметизацией. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Масса транзистора не более 0,1 г.



KT218 (A9-E9)

Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 10 мА$ для KT218A9, KT218B9, KT218B9, KT218Г9 и $U_{кб} = 1 В$, $I_э = 0,04 мА$ для KT218Д9, KT218E9:

KT218A9, не менее	20
KT218B9	30...90
KT218B9, KT218Г9	40...120
KT218Д9, не менее	80
KT218E9, не менее	40

Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 5 В$, $I_э = 1 мА$, не менее

KT218A9, KT218B9	80 В
KT218B9	60 В
KT218Г9	40 В
KT218Д9	30 В
KT218E9	20 В

Напряжение насыщения коллектор-эмиттер при $I_к = 10 мА$, $I_б = 1 мА$, не более

Напряжение насыщения база-эмиттер при $I_к = 10 мА$, $I_б = 1 мА$, не более

Емкость коллекторного перехода при $U_{кб} = 10 В$, не более

Емкость эмиттерного перехода при $U_{эб} = 0,5 В$, не более

Обратный ток коллектор-эмиттер при $R_{бэ} = 10 кОм$, не более:

KT218A9 при $U_{кэ} = 100 В$	1 мкА
KT218B9 при $U_{кэ} = 90 В$	1 мкА
KT218B9 при $U_{кэ} = 80 В$	1 мкА
KT218Г9 при $U_{кэ} = 60 В$	1 мкА
KT218Д9, KT218E9 при $U_{кэ} = 30 В$	1 мкА

Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = U_{эб, макс}$, не более

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор-эмиттер при $U = 10 кОм$:

KT218A9, KT218B9	80 В
KT218B9	60 В
KT218Г9	40 В
KT218Д9	30 В
KT218E9	20 В

Постоянное напряжение эмиттер-база:

KT218A9	30 В
KT218B9, KT218B9, KT218Д9	7 В
KT218E9	20 В

Постоянный ток коллектора

Импульсный ток коллектора при $t_{и} = 10 мс$, $Q = 100$

Постоянный ток базы

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора¹ при $T = -60...+25^{\circ}C$

Температура $p-n$ перехода

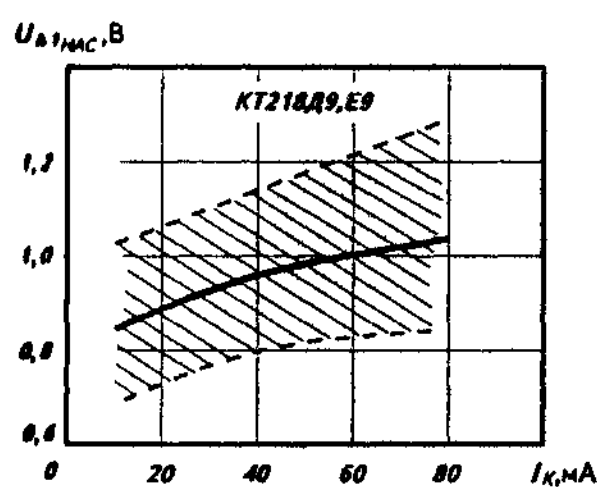
Тепловое сопротивление переход-среда

Температура окружающей среды

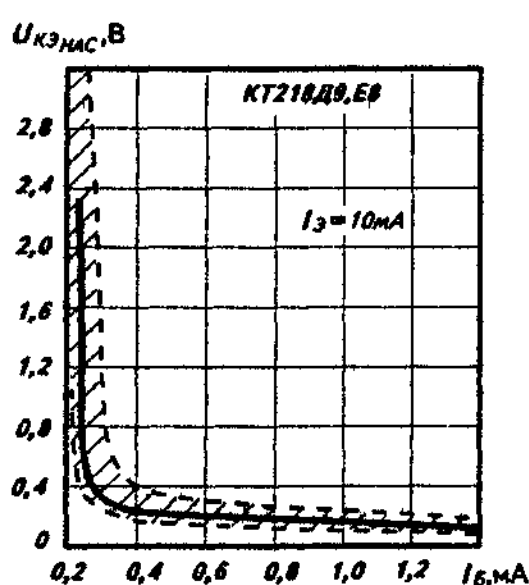
¹ При $T > +25^{\circ}C$ максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора рассчитывается по формуле

$$P_{к, макс} = (125 - T) / 0,5, мВт$$

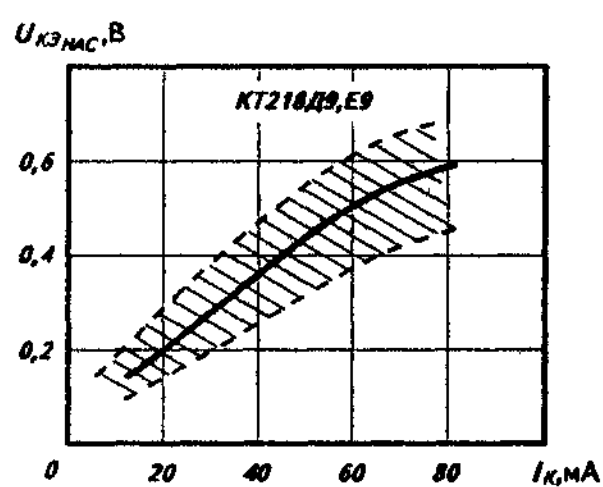
Пайку выводов рекомендуется проводить с применением лудящих паст и припоев на расстоянии не менее 0,15 мм от корпуса транзистора, время пайки не более 4 с, температура пайки не более $+265^{\circ}C$.



Зависимость напряжения насыщения эмиттер-база от тока коллектора.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока базы.



Зависимость напряжения насыщения коллектор-эмиттер от тока коллектора.